

М. Я. АЗБЕЛЬ и М. И. КАГАНОВ

**К ТЕОРИИ АНОМАЛЬНОГО СКИН-ЭФФЕКТА
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ**

(Представлено академиком Л. Д. Ландау 21 XII 1953)

1. В настоящем сообщении рассматривается отражение плоской монохроматической волны частоты ω от поверхности металла, помещенного в постоянное магнитное поле H_0 . Магнитное поле перпендикулярно поверхности металла, направление распространения электромагнитной волны параллельно магнитному полю.

Поведение электронов проводимости описывается при помощи функции распределения f , которая удовлетворяет известному кинетическому уравнению (1):

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} \mathbf{v} + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \mathbf{F} = -\frac{f - f_0}{\tau}. \quad (1)$$

Здесь \mathbf{F} — сила, действующая на электрон, в нашем случае

$$\mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}, \mathbf{H}] + \frac{1}{c}[\mathbf{v}, \mathbf{H}_0]); \quad (2)$$

\mathbf{E} , \mathbf{H} — переменные составляющие электромагнитного поля в металле; f_0 — фермиевская функция распределения; \mathbf{v} — скорость электрона, в общем случае

$$\mathbf{v} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{p}}, \quad (3)$$

где ε и \mathbf{p} — энергия и квазиимпульс электрона; τ — время релаксации. Плотность тока проводимости при этом равна

$$\mathbf{j} = \frac{2e}{(2\pi\hbar)^3} \int \mathbf{v}(\mathbf{p}) f(t; \mathbf{r}, \mathbf{p}) d\tau_{\mathbf{p}} \quad (4)$$

($d\tau_{\mathbf{p}} = dp_x dp_y dp_z$, интегрирование ведется по всему \mathbf{p} -пространству).

Наличие магнитного поля ограничивает применимость кинетического уравнения (1) той областью температур и магнитных полей, где

$$\hbar\omega_L \ll kT \quad \left(\omega_L = \frac{eH_0}{mc}\right).$$

Мы будем предполагать, что это условие всегда выполнено.

2. В работе (1) и в ряде других работ (2, 3), используя решения уравнения (1) при $H_0 = 0$, построена теория частотной зависимости поверхностного импеданса металлов в предположении, что

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}. \quad (5)$$

Легко видеть, что упомянутая теория не нуждается в подобном упрощающем предположении, а формулы, полученные в (1) для $Z = \frac{4\pi E(0)}{c H(0)}$, справедливы при произвольном изотропном законе дисперсии $\varepsilon = \varepsilon(p)$.

Результаты работы (1) удается, кроме того, обобщить на случай анизотропии эффективных масс. Считая, что

$$\varepsilon = \frac{p_x^2}{2m_x} + \frac{p_y^2}{2m_y} + \frac{p_z^2}{2m_z}, \quad (6)$$

можно найти

$$Z_j = \frac{8}{9} \left(\sqrt{3} \pi \omega^2 \frac{l_z}{\sigma_j} \right)^{1/2} (1 + \sqrt{3} i)^*. \quad (7)$$

Здесь $j = x, y$ и предположено, что электрическое поле направлено вдоль оси j (ось z перпендикулярна поверхности металла);

$$\frac{\sigma_j}{l_z} = \frac{e^2 n^{1/2}}{(3\pi^2)^{1/2}} \frac{m_z}{m_j} \sqrt[6]{\frac{m_x m_y}{m_z^2}}. \quad (8)$$

Выражение (7) справедливо для предельного случая больших по сравнению со скин-глубиной проникновения длин свободного пробега и зеркального отражения электронов от границы металла.

3. Вернемся к решению поставленной задачи. Введем в рассмотрение отклонение функции распределения f_1 от ее равновесного значения

$$f_1 = f - f_0.$$

Линеаризуя кинетическое уравнение (3), получим, считая закон дисперсии изотропным:

$$\frac{1 + i\omega\tau}{\tau v} f_1 + n_z \frac{\partial f_1}{\partial z} + \frac{1}{r} \left(n_x \frac{\partial f_1}{\partial n_y} - n_y \frac{\partial f_1}{\partial n_x} \right) = \frac{e}{v} \frac{\partial f_0}{\partial p} (n_x E_x + n_y E_y). \quad (9)$$

Здесь $r = pc / eH_0$, а \mathbf{n} — единичный вектор в направлении \mathbf{p} ($\mathbf{n} = \mathbf{p}/p$).

Решение уравнения (9) ищем в виде

$$f_1 = n_x C_1(z) + n_y C_2(z). \quad (10)$$

Обозначив $C_{\pm} = C_1 \pm iC_2$, $E_{\pm} = E_x \pm iE_y$, из (9) получаем

$$\frac{\partial C_{\pm}}{\partial z} + \frac{1 + i(\omega \mp \Omega)\tau}{\tau v_z} C_{\pm} = \frac{e}{v_z} \frac{\partial f_0}{\partial p} E_{\pm}, \quad (11)$$

где $\Omega = -veH_0 / pc$ (при $v = p/m$ $\Omega = \omega_L$).

Решение уравнения (11) с обычными граничными условиями (1, 4) после подстановки в выражение для плотности тока (4) дает

$$j_{\pm} = \frac{2\pi e^2 p^2}{(2\pi\hbar)^3} \left\{ q \int_{-\infty}^{\infty} K_{\pm} \left(\frac{z-t}{e} \right) E_{\pm}(t) dt + (1-q) \int_0^{\infty} K_{\pm} \left(\frac{z-t}{e} \right) E_{\pm}(t) dt \right\}. \quad (12)$$

Здесь

$$K_{\pm}(u) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 \theta}{\cos \theta} e^{-\frac{1+i(\omega \pm \Omega)\tau}{\cos \theta} |u|} d\theta. \quad (13)$$

Параметр q указывает на характер отражения электронов на границе металла; $q = 1$ соответствует зеркальному отражению, $q = 0$ диффузному рассеянию (1, 4). Все величины берутся при $p = (3\pi^2)^{1/2} n^{1/2} 2\pi\hbar$.

Полученная связь между электрическим полем и током совпадает с аналогичным выражением теории аномального скин-эффекта в отсут-

$$* \quad Z_x = \frac{4\pi}{c} \frac{E_x(0)}{H_y(0)}; \quad Z_y = -\frac{4\pi}{c} \frac{E_y(0)}{H_x(0)}.$$

ствие магнитного поля (см. формулу (14) из (1)) с точностью до сдвига частоты ω на величину $\mp\Omega$. Это позволяет воспользоваться результатами цитированной работы:

$$Z_{\pm} = \frac{8i\omega l}{c^2} \frac{1}{1 + i(\omega \mp \Omega)\tau} \int_0^{\infty} \frac{dt}{t^2 + \xi_{\pm} K(t)}; \quad (14)$$

$$Z_{\pm} = \frac{4\pi}{c} \frac{E_x(0) \pm iE_y(0)}{H_y(0) \mp iH_x(0)};$$

$$\xi_{\pm} = \frac{\frac{3}{2} i \frac{l^2}{8^2}}{[1 + i(\omega \mp \Omega)\tau]^3}; \quad K(t) = \frac{2}{t^3} \{(1 + t^2) \operatorname{arctg} t - t\}.$$

Мы ограничились случаем зеркального отражения электронов от поверхности металла ($q = 1$) как более легким; из (1) и из дальнейшего ясно, что диффузное рассеяние существенно не изменяет значения поверхностного импеданса.

Когда $|\xi_{\pm}| \ll 1$, т. е. когда

$$\frac{3}{2} \frac{l^2}{8^2} \ll [1 + (\omega \mp \Omega)^2 \tau^2]^{3/2}, \quad (15)$$

можно показать, что первое приближение получается при замене функции $K(t)$ ее значением в нуле ($K(0) = 4/3$). Вычисляя получающийся элементарный интеграл, находим

$$Z_{\pm}^{\text{кл}} = \sqrt{\frac{2\pi\omega}{c^2\sigma}} \left\{ \sqrt{V(\omega \mp \Omega)^2 \tau^2 + 1} - (\omega \mp \Omega)\tau + i \sqrt{V(\omega \mp \Omega)^2 \tau^2 + 1} + (\omega \mp \Omega)\tau \right\}. \quad (16)$$

(Мы обозначили найденное выражение $Z_{\pm}^{\text{кл}}$, отметив этим тот факт, что оно может быть получено заменой $\omega\tau$ на $(\omega \mp \Omega)\tau$ в классическом выражении для импеданса).

В обратном предельном случае

$$\frac{3}{2} \frac{l^2}{8^2} \gg [1 + (\omega \mp \Omega)^2 \tau^2]^{3/2} \quad (15')$$

импеданс не зависит от величины магнитного поля

$$Z_{\pm} = \frac{8}{9} \left(\sqrt{3} \frac{\pi\omega^2 l}{c^4\sigma} \right)^{1/2} (1 + \sqrt{3}i). \quad (17)$$

Условия применимости выражений (16) и (17) существенно зависят от величины магнитного поля (см. (15) и (15')).

4. При отражении электромагнитной волны от поверхности металла происходит ряд эффектов (скачок фазы, изменение направления поляризации, поглощение энергии), численные характеристики которых легко получить, зная отношение амплитуд отраженных волн к амплитуде падающей волны E_0 .

Если считать, что падающая волна поляризована вдоль оси x , то:

$$\frac{(E_{\text{отр}})_x}{E_0} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\frac{cZ_+}{4\pi} - 1}{\frac{cZ_+}{4\pi} + 1} + \frac{\frac{cZ_-}{4\pi} - 1}{\frac{cZ_-}{4\pi} + 1} \right\}, \quad (18)$$

$$\frac{(E_{\text{отр}})_y}{E_0} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\frac{cZ_+}{4\pi} - 1}{\frac{cZ_+}{4\pi} + 1} - \frac{\frac{cZ_-}{4\pi} - 1}{\frac{cZ_-}{4\pi} + 1} \right\}.$$

5. Рассмотрим более подробно явление резонанса ($\omega = \Omega$) в условиях аномального скин-эффекта, т. е. при $l/\delta \gg 1$. Последнее неравенство показывает, что Z_+ определяется формулой (17):

$$Z_+ = \frac{8}{9} \left(\sqrt{3} \frac{\pi \Omega^2 l}{c^4 \sigma} \right)^{1/2} (1 + \sqrt{3} i) \quad (\omega = \Omega). \quad (19)$$

Если $\Omega \tau \gg 1$, то возможно, что

$$1 \ll \frac{l}{\delta} \ll (\Omega \tau)^{3/2}, \quad (20)$$

и Z_- определяется формулой (16)

$$Z_- = 2 \sqrt{\Omega \tau} \left(\frac{2\pi \Omega}{c^2 \sigma} \right)^{1/2} \left(i + \frac{1}{4\Omega \tau} \right). \quad (19')$$

Заменяя ω через Ω , легко убеждаемся, что условия (20) действуют в одну сторону:

$$r \ll \sqrt{\frac{c^2 \tau}{2\pi \sigma}}; \quad r \ll \sqrt{\frac{c^2 \tau}{2\pi \sigma}} \left(\frac{l}{\sqrt{c^2 \tau / 2\pi \sigma}} \right)^3.$$

Какое из двух условий более строго, зависит от соотношения между длиной свободного пробега l и величиной $\sqrt{\frac{c^2 \tau}{2\pi \sigma}}$, которая равна $\frac{a}{\pi \sqrt{2}} \left(\frac{mc^2}{e^2 a} \right)^{1/2} \simeq 10^3 a$ (здесь a — атомные размеры, $m = p/v$).

В заключение авторы пользуются случаем выразить благодарность И. М. Лифшицу за ценные советы, а также А. А. Галкину за обсуждение полученных результатов.

Поступило
26 XI 1953

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ G. E. H. Reuter, E. H. Sondheimer, Proc. Roy. Soc., **195**, 336 (1949).
² А. А. Абрикосов, ДАН, **87**, 43 (1952). ³ R. V. Dingle, Physica, **19**, 311 (1953).
⁴ K. Fuchs, Proc. Cambr. Phil. Soc., **34**, 100 (1938).